

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2013 年 3 月 21 日(21.03.2013)



(10) 国際公開番号
WO 2013/039203 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/304 (2006.01) *B24B 37/26* (2012.01)
B24B 37/20 (2012.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2012/073633
- (22) 国際出願日: 2012 年 9 月 14 日(14.09.2012)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2011-202761 2011 年 9 月 16 日(16.09.2011) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東レ株式会社 (TORAY INDUSTRIES, INC.) [JP/JP]; 〒1038666 東京都中央区日本橋室町 2 丁目 1 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 本田 智之 (HONDA, Tomoyuki) [JP/JP]; 〒5208558 滋賀県大津市園山 1 丁目 1 番 1 号 東レ株式会社滋賀事業場内 Shiga (JP). 福田 誠司 (FUKUDA, Seiji) [JP/JP];

〒5208558 滋賀県大津市園山 1 丁目 1 番 1 号 東レ株式会社滋賀事業場内 Shiga (JP). 奥田 良治 (OKUDA, Ryoji) [JP/JP]; 〒5208558 滋賀県大津市園山 1 丁目 1 番 1 号 東レ株式会社滋賀事業場内 Shiga (JP).

(74) 代理人: 酒井 宏明 (SAKAI, Hiroaki); 〒1006020 東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 5 号 霞が関ビルディング 酒井国際特許事務所 Tokyo (JP).

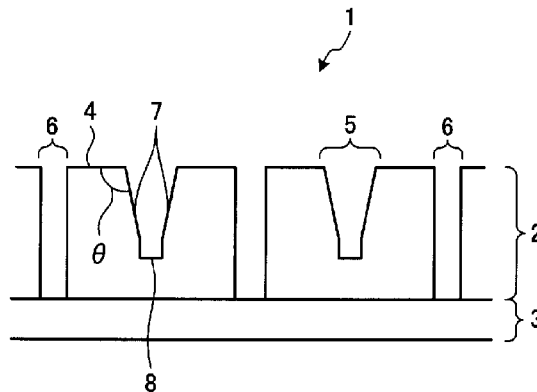
(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

[続葉有]

(54) Title: POLISHING PAD

(54) 発明の名称: 研磨パッド

[図1]



(57) Abstract: In order to inhibit the deterioration in the wafer in-plane uniformity and any decrease in polishing rate due to insufficient polishing rate at the center portion of the wafer, a polishing pad has at least a polishing layer and a cushion layer, the polishing layer having a plurality of holes penetrating in the thickness direction, a plurality of grooves being provided to the polishing surface of the polishing layer, the penetration hole ratio being 0.13% to 2.1%, and the angle between the polishing surface and the groove-side surfaces continuous from the polishing surface being 105-150° for both side surfaces.

(57) 要約: ウェハ中央部の研磨レート不足による研磨レートの低下とウェハ一面内均一性の悪化を抑制するため、研磨パッドは、少なくとも研磨層とクッション層を有する研磨パッドであって、前記研磨層には厚さ方向に貫通する複数の孔が設けられていると共に、前記研磨層の研磨面には複数の溝が設けられ、貫通孔率が0.13%以上2.1%以下であり、前記研磨面と該研磨面に連続する溝側面とのなす角度は、両側面とも105度以上150度以下である。



WO 2013/039203 A1



(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR),

OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))